

令和元年 基礎・材料・共通部門大会セッションプログラム

セッション名の後の()内は件数です

日時 会場	9月3日(火)					9月4日(水)		
	午前		午後			午前		午後
A会場 22講義室	3-A-a1 9:00～10:30 放電基礎・現象Ⅰ (6)	3-A-a2 10:45～12:00 放電基礎・現象Ⅱ (5)	3-P 13:15～15:15 ポスター発表 P会場 12, 13講義室	特別講演 15:30～17:00 テクノホール	表彰式 17:30～17:45 理工学部カフェテリア	4-A-a1 9:00～10:30 放電基礎・現象Ⅲ (6)	4-A-a2 10:45～11:45 放電応用Ⅰ (4)	4-A-p1 13:00～14:00 放電応用Ⅱ (4)
B会場 23講義室	3-B-a1 9:00～10:30 誘電・絶縁材料Ⅰ (6)	3-B-a2 10:45～12:00 誘電・絶縁材料Ⅱ (5)	コアタイム ポスター番号 奇数：13:15～14:15 偶数：14:15～15:15		懇親会 17:45～19:00 理工学部カフェテリア	4-B-a1 9:00～10:30 誘電・絶縁材料Ⅲ (6)	4-B-a2 10:45～11:45 誘電・絶縁材料Ⅳ (4)	4-B-p1 13:00～14:45 誘電・絶縁材料Ⅴ, 誘電・絶縁材料の計測 (7)
C会場 24講義室	3-C-a1 9:00～10:15 光応用・視覚, 電磁界 理論, 半導体・機能・ 超電導材料 (5)	3-C-a2 10:30～11:45 教育・研究 (5)				4-C-a1 9:00～10:15 電磁環境 (5)	4-C-a2 10:30～11:45 金属・セラミックス (5)	4-C-p1 13:00～14:45 計測 (7)
D会場 25講義室	3-D-a1 9:00～10:30 プラズマⅠ (6)	3-D-a2 10:45～12:00 プラズマⅡ (5)				4-D-a1 9:00～10:15 プラズマⅢ (5)	4-D-a2 10:30～11:30 パルスパワーⅠ (4)	4-D-p1 13:00～14:00 パルスパワーⅡ (4)
E会場 17講義室	3-E-a1 9:00～12:35 テーマ付セッション ナノ構造制御・評価と有機デバイス・センサの 高性能化 (9+③)							
F会場 16講義室	3-F-a1 9:00～11:30 テーマ付セッション 高密度エネルギー変換 システムにおける技術 動向 (5+③)	3-F-a2 11:45～12:15 磁性材料・磁気応用・ マイクロ磁気Ⅰ (2)				4-F-a1 9:00～10:30 磁性材料・磁気応用・ マイクロ磁気Ⅱ (6)	4-F-a2 10:45～12:30 磁性材料・磁気応用・ マイクロ磁気Ⅲ (7)	

※ 丸数字は企業招待講演の件数